

HSM221C

シリコンエピタキシャルプレーナ形
シングルダイオード
高速度スイッチング用

SILICON EPITAXIAL PLANAR
HIGH SPEED SWITCHING

特長 FEATURES

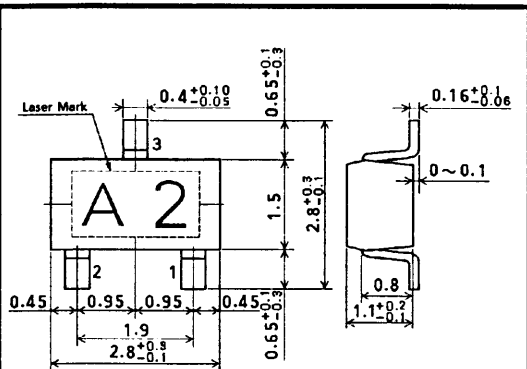
- 低端子間容量および高耐圧形です。
- 逆回復時間が小さいです。
- MPAK外形のため面装着に対応できました、小形設計および高密度実装が可能です。
- Low Capacitance.
- Proof against high voltage.
- Fast Recovery Time.
- MPAK structure enables easy mounting and high reliability.

絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(特に指定のない場合は、周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$)
(25°C ambient temperature unless otherwise specified.)

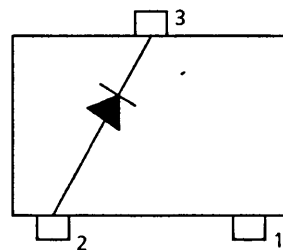
項目	Symbol	HSM221C	Unit
せん頭逆電圧	$V_R(\text{peak})$	85	V
逆電圧	V_R	80	V
せん頭順電流	$I_F(\text{peak})$	300	mA
平均整流電流	I_O	100	mA
サージ順電流	$I_F(\text{surge})$	4	A
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

外形図



(MPAK) (Dimensions in mm)

1. NC: NC
2. アノード: Anode
3. カソード: Cathode



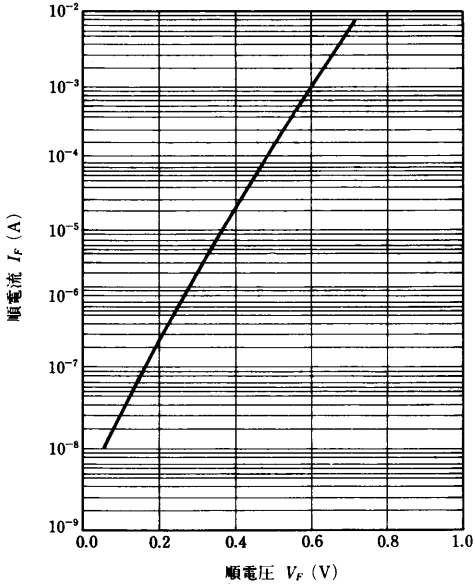
電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(特に指定のない場合は、周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$)
(25°C ambient temperature unless otherwise specified.)

項目	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
順電圧	V_{F1}	$I_F = 10\text{mA}$	-	0.76	1.0	V
	V_{F2}	$I_F = 50\text{mA}$	-	0.88	1.0	
	V_{F3}	$I_F = 100\text{mA}$	-	0.97	1.2	
逆電流	I_R	$V_R = 80\text{V}$	-	-	0.1	μA
端子間容量	C	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	-	2.0	pF
逆回復時間	t_{rr}	$I_F = 10\text{mA}, V_R = 6\text{V}, R_L = 50\Omega$	-	-	3.0	ns

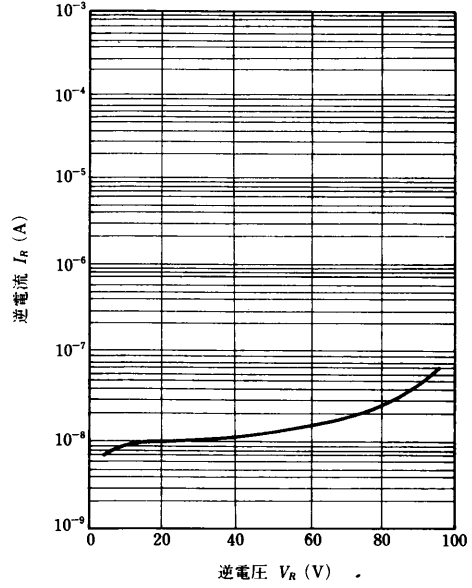
順特性

FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE



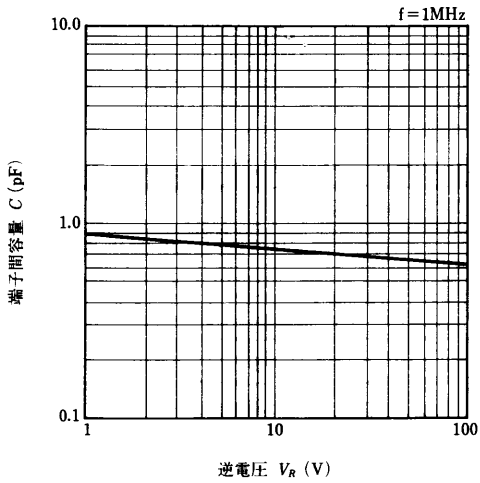
逆特性

REVERSE CURRENT VS. REVERSE VOLTAGE



端子間容量 对 逆电压特性

CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE



HSM223C

シリコンエピタキシャルプレーナ形
シングルダイオード
高速度スイッチング用

SILICON EPITAXIAL PLANAR
HIGH SPEED SWITCHING

特 長 FEATURES

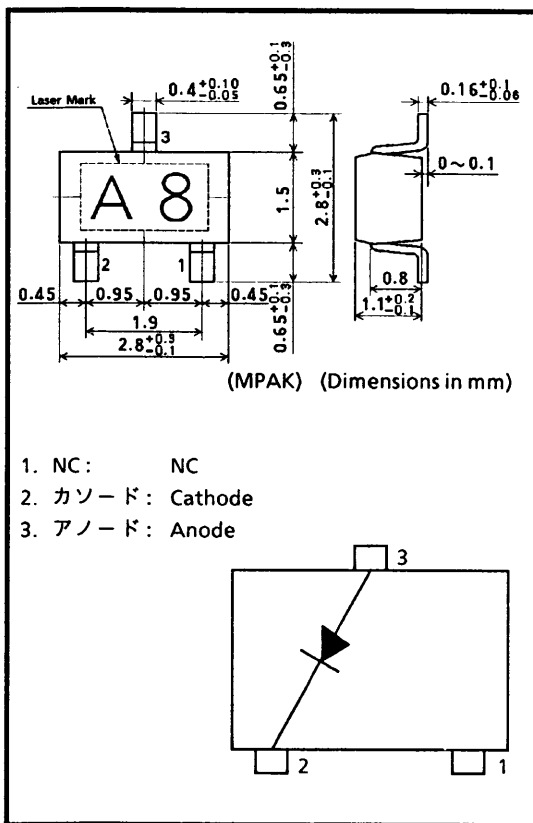
- 低端子間容量および高耐圧形です。
- 逆回復時間が小さいです。
- MPAK外形のため面装着に対応できました、小形設計および高密度実装が可能です。
- Low Capacitance.
- Proof against high voltage.
- Fast Recovery Time.
- MPAK structure enables easy mounting and high reliability.

絶 対 最 大 定 格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(特に指定のない場合は、周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$)
(25°C ambient temperature unless otherwise specified.)

項 目	Symbol	HSM223C	Unit
せん頭逆電圧	$V_R(\text{peak})$	85	V
逆 電 圧	V_R	80	V
せん頭順電流	$I_F(\text{peak})$	300	mA
平均整流電流	I_O	100	mA
サージ順電流	$I_F(\text{surge})$	4	A
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	$-55 \sim +125$	$^\circ\text{C}$

外 形 図



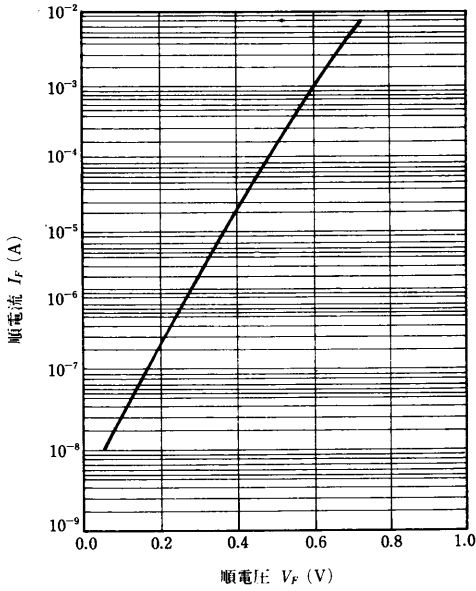
電 気 的 特 性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(特に指定のない場合は、周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$)
(25°C ambient temperature unless otherwise specified.)

項 目	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
順 電 圧	V_{F1}	$I_F = 10\text{mA}$	-	0.76	1.0	V
	V_{F2}	$I_F = 50\text{mA}$	-	0.88	1.0	
	V_{F3}	$I_F = 100\text{mA}$	-	0.97	1.2	
逆 電 流	I_R	$V_R = 80\text{V}$	-	-	0.1	μA
端 子 間 容 量	C	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	-	2.0	pF
逆 回 復 時 間	t_{rr}	$I_F = 10\text{mA}, V_R = 6\text{V}, R_L = 50\Omega$	-	-	3.0	ns

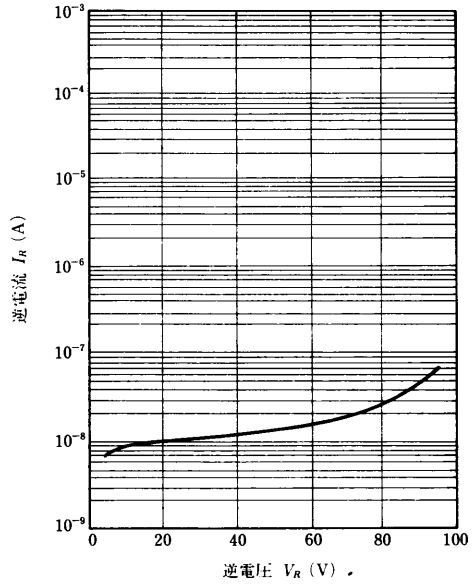
順特性

FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE



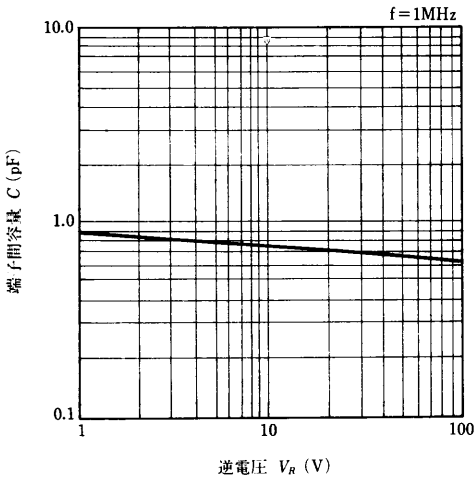
逆特性

REVERSE CURRENT VS. REVERSE VOLTAGE



端子間容量 对 逆电压特性

CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE



HSM276S

シリコンショットキバリア形

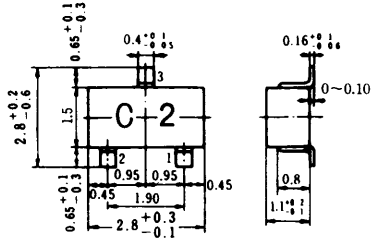
CATV チューナミキサ用

SILICON SCHOTTKY BARRIER

CATV TUNER MIXER

■特長

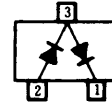
- 高順電流、低静電容量形です。
- HSM276Sは、2個のダイオードがシリーズ接続されていますので、容易にバランスドミキサが構成できます。
- MPAK (EIAJ SC-59) 外形のため、面装着により高密度、高速部品実装が可能です。



(MPAK)

■FEATURES

- High forward current, low capacitance.
- MPAK (EIAJ SC-59) structure assures ensures high density assembly.
- HSM276S which is interconnected in series configuration is designed for balanced mixer use.



1. カソード2 : Cathode 2
 2. アノード1 : Anode 1
 3. カソード1, アノード2 : Cathode 1, Anode 2
 (Dimensions in mm)

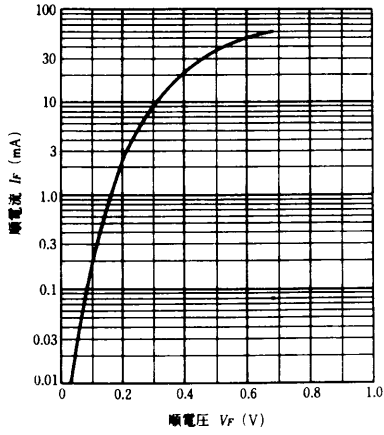
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	HSM276S	Unit
逆	電 圧	V_R	3	V
平 均	整 流 電 流	I_O	30	mA
接 合 部	温 度	T_j	100	$^\circ\text{C}$
保 存	温 度	T_{stg}	-55~+100	$^\circ\text{C}$

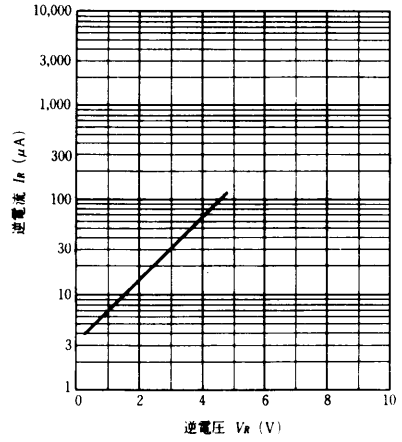
■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
逆	電 圧	V_R	$I_R=1\text{mA}$	3	—	—	V
逆	電 流	I_R	$V_R=0.5\text{V}$	—	—	50	μA
順	電 流	I_F	$V_F=0.5\text{V}$	35	—	—	mA
端 子 間	容 量	C	$V_R=0.5\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	—	0.90	pF
組 内	容 量 偏 差	ΔC	$V_R=0.5\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	—	0.10	pF

順特性
FORWARD CHARACTERISTICS



逆特性
REVERSE CHARACTERISTICS



端子間容量对逆電圧特性
CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

